

# ST 1 - Tutorübung - Blatt 9 (12.1.10)

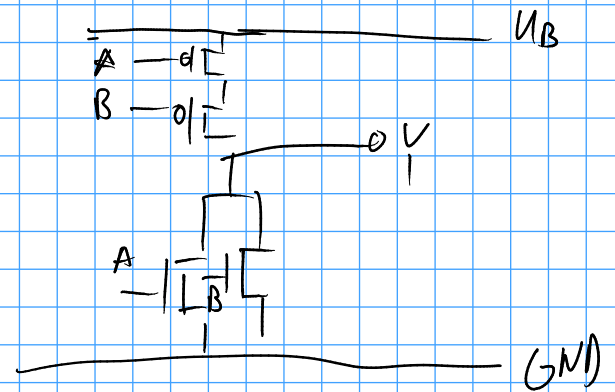
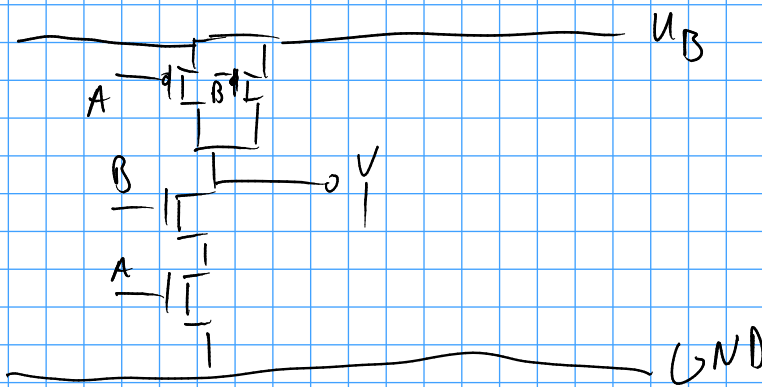
## CMOS - Schaltungen / Logiksynthese

NAND  $\overline{a \cdot b}$

a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

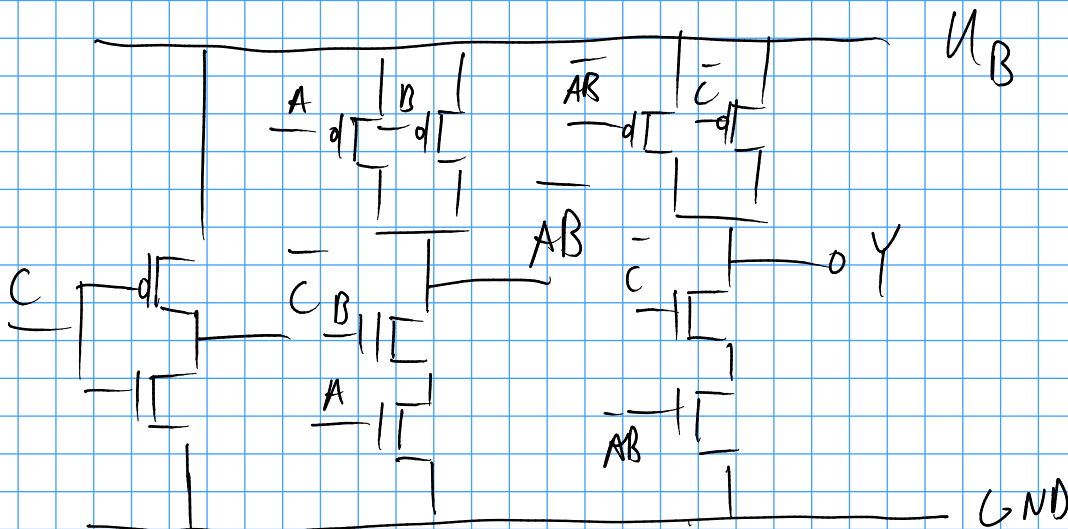
NOR  $\overline{a + b}$

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



$$Y = \overline{AB + C} = \overline{AB} \cdot \overline{C}$$

$\overline{AB} \cdot \overline{C}$ 
  
NAND Inverter

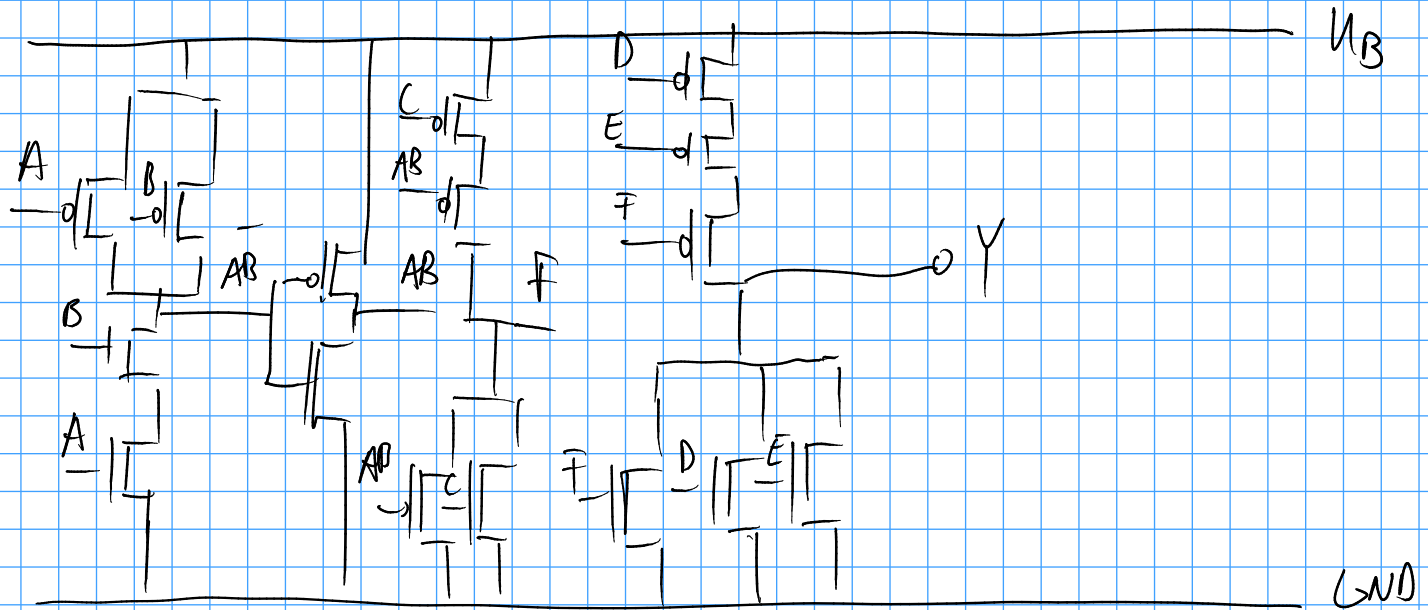


~~\*~~ (siehe Ende)

# Aufgabe 1:

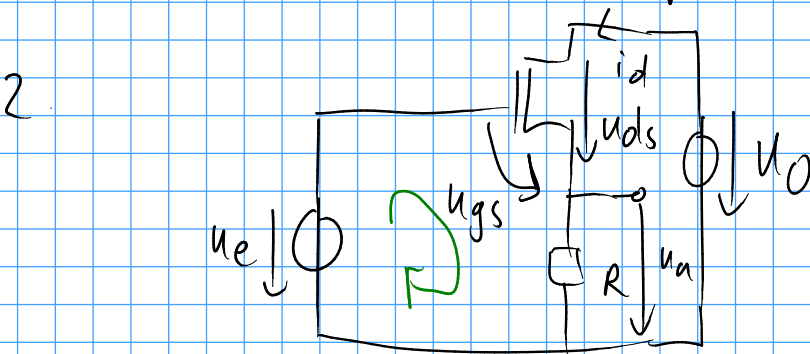
$$Y = (AB + C) \cdot (\overline{D + E}) = \overline{\overline{AB + C} + \overline{D + E}} = \overline{\overline{AB + C} + \overline{D + E}} \quad \text{NOR}$$

$\underbrace{\overline{\overline{AB + C} + \overline{D + E}}}_{\text{NOR}}$   
 $\underbrace{\hspace{10em}}_F$



# Aufgabe 2

1.  $u_{ds} \geq 0V$  durch äußere Beschaltung festgelegt!



Sperrbereich:  $u_{gs} - U_{th} \leq 0$

$$u_e = u_{gs} + u_a = u_{gs} + \frac{R \cdot i_d}{\phantom{=0}} = 0$$

Annahme:  $i_d = 0$

$$u_e = u_{gs} \Rightarrow u_{gs} > U_{th}$$

⇒ Annahme kann nicht zutreffen

3. Arbeitsbereich für:  $U_{th} < u_e < U_0$

Sättigung:  $0 \leq u_{gs} - U_{th} \leq u_{ds}$

Linear:  $0 \leq u_{gs} - U_{th} \leq u_{ds}$

KVL:  $u_{ds} = U_0 - u_a$

$u_{gs} = u_e - u_a$

$$u_{ds} - u_{gs} = U_0 - \underbrace{u_a} - u_e + \underbrace{u_a} = U_0 - u_e > 0$$

$$u_{ds} - u_{gs} > 0 > -U_{th} \Leftrightarrow u_{gs} - U_{th} < u_{ds}$$

$\underbrace{-1V}_{-1V} \Rightarrow$  Sättigungsbereich  $\triangleright$

4. Bereich: Sättigung

ges:  $u_a$

$$\begin{aligned} u_a = R_{id} &= \frac{R_B}{2} (u_{gs} - U_{th})^2 = \frac{R_B}{2} (u_e - u_a - U_{th})^2 \\ &= \frac{R_B}{2} (u_e^2 - 2u_e u_a + u_a^2 - 2u_e U_{th} + 2u_a U_{th} + U_{th}^2) \end{aligned}$$

↳  $ax^2 + bx + c = 0$

$$\frac{R_B}{2} u_a^2 + u_a (-R_B u_e + R_B U_{th} - 1) + \frac{R_B}{2} u_e^2 - R_B u_e U_{th} + \frac{R_B}{2} U_{th}^2 = 0$$

$$\Rightarrow u_a = \left( u_e - U_{th} + \frac{1}{R_B} \right) \sqrt{\frac{1}{R^2 \beta^2} + \frac{2}{R_B} (u_e - U_{th})}$$

beschreibt die richtige Lösung

Welche Lösung ist nun die richtige?  $\rightarrow$  Wir wissen, dass auf alle Fälle  $u_{gs} - U_{th} > 0$  sein muss, da der MOSFET sonst überhaupt nicht leiten würde:

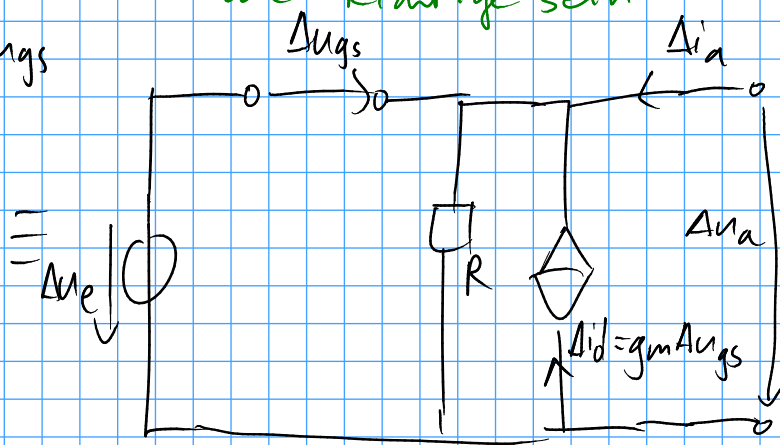
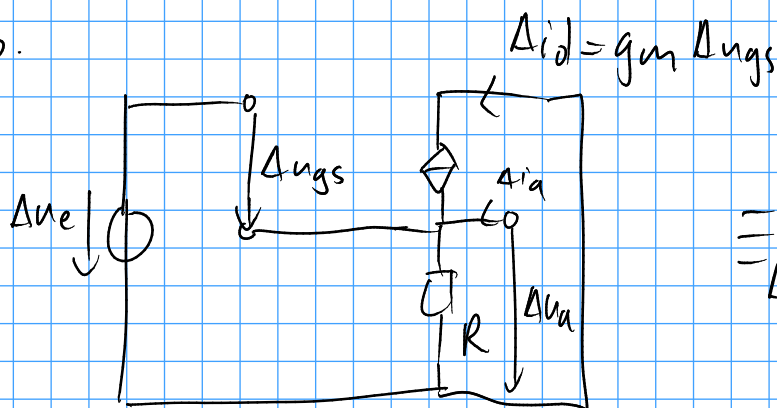
$$u_{gs} = u_e - u_a = u_e - u_e + U_{th} - \frac{1}{R_B} \sqrt{\frac{1}{R^2 \beta^2} + \frac{2}{R_B} (u_e - U_{th})}$$

wird von oben eingesetzt

$$u_{gs} - U_{th} = -\frac{1}{R_B} \sqrt{\dots} > 0 \Rightarrow \text{Wurzel sicher positiv, also ist } -\frac{1}{R_B} \sqrt{\dots} < 0, \text{ also}$$

muss die andere Lösung die richtige sein

6.



$$7. v = \frac{\Delta u_a}{\Delta u_e} \Big|_{\Delta i_a = 0}$$

$$\Delta u_e = \Delta u_{gs} + \Delta u_a$$

$$\Delta u_a = R \Delta i_d =$$

$$= \Delta u_{gs} + R \Delta i_d =$$

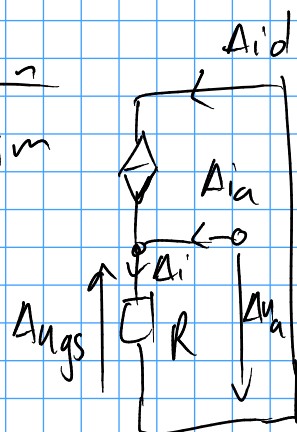
$$= R g_m \Delta u_{gs}$$

$$\Delta u_{gs} + R g_m \Delta u_{gs}$$

$$v = \frac{\Delta u_a}{\Delta u_e} = \frac{R g_m \Delta u_{gs}}{\Delta u_{gs} + R g_m \Delta u_{gs}} = \frac{R g_m}{1 + R g_m}$$

$$8. u_a = \frac{\Delta u_a}{\Delta i_a} \Big|_{\Delta u_e = 0}$$

$\Rightarrow$



$$\Delta i_a = -\Delta i_d + \frac{\Delta u_a}{R} = g_m \Delta u_a + \frac{\Delta u_a}{R}$$

$$r_a = \frac{\Delta u_a}{g_m \Delta u_a + \frac{\Delta u_a}{R}} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R}} = \frac{R}{1 + g_m R}$$

g.  $g_m \gg \frac{1}{R}$

$$V = \frac{R g_m}{1 + R g_m} = \frac{g_m}{\frac{1}{R} + g_m} \approx \frac{g_m}{g_m} = 1$$

$$\Rightarrow r_a = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

Anmerkung zum Einführungsbeispiel:

$$Y = AB + C = \overline{AB + C}$$

elegantere Möglichkeit:

